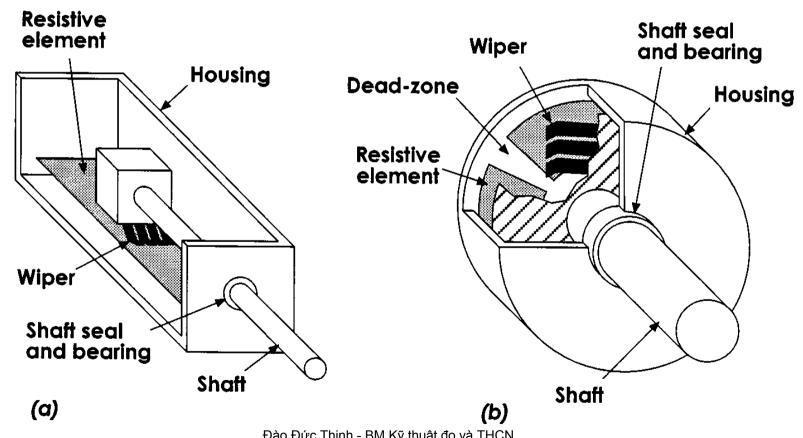
# Kỹ thuật cảm biến

Cảm biến điện trở





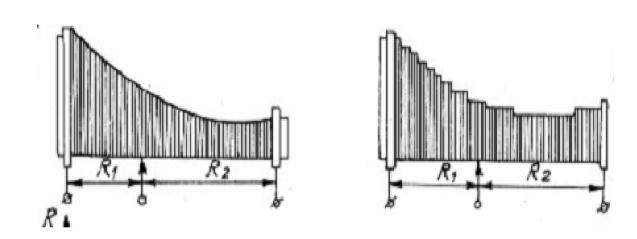
#### Cấu tạo:



Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

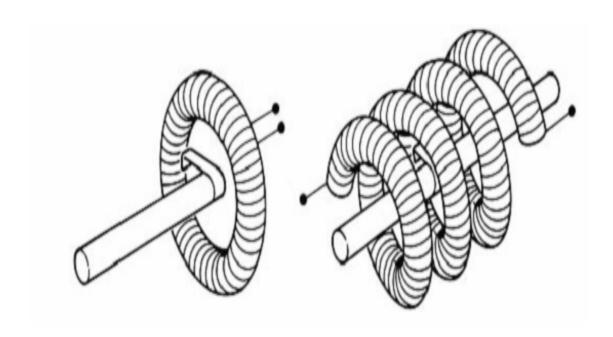








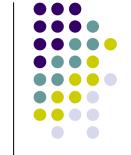








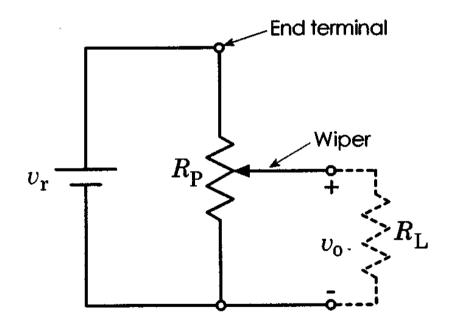
- Lõi bằng vật liệu cách điện.
- Dây quấn dẫn điện có phủ sơn cách điện.
- Bộ than chì ép thành lớp dẫn điện.
- Con trượt.
- Thanh trượt

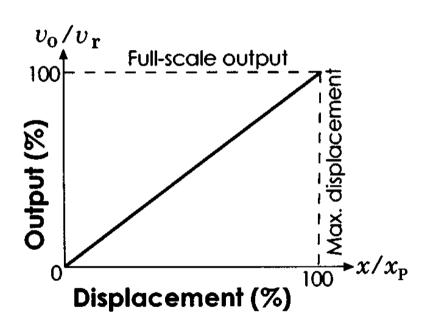


- Nguyên lý hoạt động: Khi con trượt chạy trên thanh trượt thì tuỳ thuộc vào vị trí của nó mà điện trở thay đổi.
- Quan hệ giữa di chuyển X đầu vào và R ra có thể là tuyến tính hay theo đặc tính nào đó.



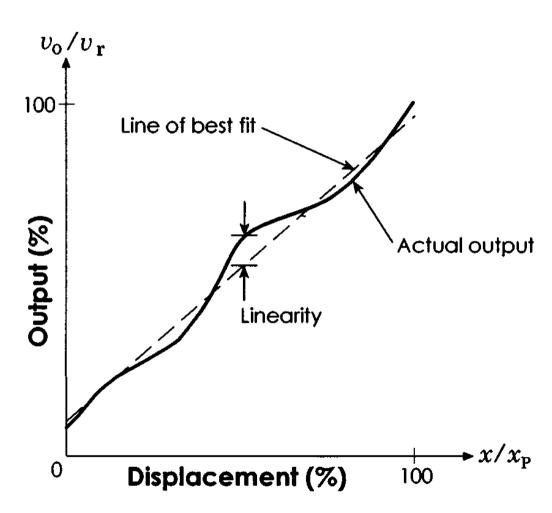








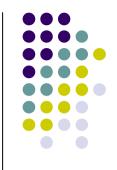




Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN



	Dẫn bằng than chì	Dây quấn	Hybrid
Độ phân giải	Lớn	Giới hạn	Lớn
Công suất	Thấp	Cao	Thấp
Độ ổn định nhiệt độ	Kém	Rất tốt	Tốt
Noise	Rất thấp	Thấp nhưng giảm theo t	Thấp
Tuổi thọ	1-100 triệu lần	0.1-1 triệu lần	1-10 triệu lần



- Độ nhạy: với CB điện trở dây quấn có W
  vòng
- Độ di chuyển nhỏ nhất có thể đo:

$$X_0 = \frac{L}{W}$$

Sai số rời rạc:

$$\gamma = \frac{\Delta R_{\min}}{2R} = \frac{R_0}{2R} = \frac{1}{2W}$$





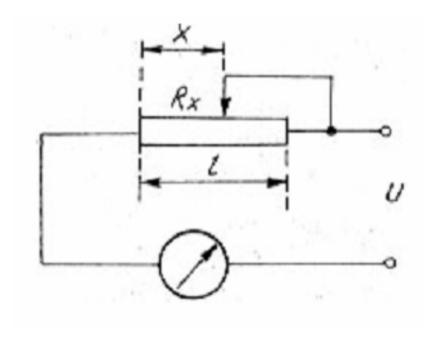
- Sai số phi tuyến: 0,1-1%
- Sai số do nhiệt độ: 0,1%/10 độ C
- Giá trị thay đổi của điện trở: vài Ω đến vài
  MΩ
- Công suất: vài phần W đến vài trăm W.



- Lực để di chuyển biến trở.
- Khoảng di chuyển.
- Tốc độ di chuyển.
- Tuổi thọ.
- Vỏ bảo vệ



Mạch biến trở:



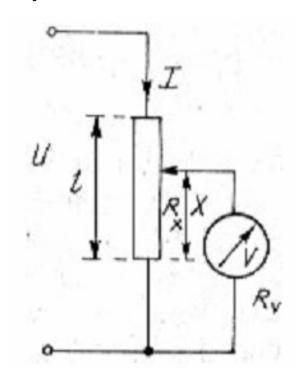


$$I = \frac{U}{R_x + R_{CT}} = \frac{U}{R \cdot \frac{X}{l} + R_{CT}} = f(X)$$

Quan hệ là phi tuyến



Mạch phân áp







$$U_X = I.(R_X // R_V) = \frac{U}{(R - R_X) + (R_X // R_V)}.(R_X // R_V)$$

nếu  $R_V >> R_X \Rightarrow (R_X // R_V) \approx R_X$ , có:

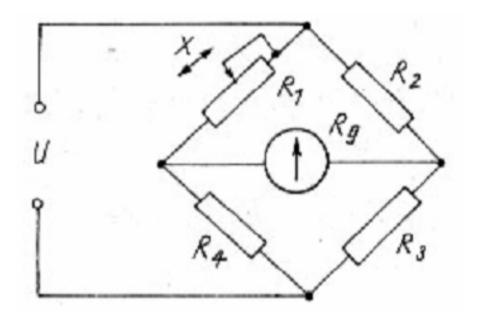
$$U_{X} = \frac{U}{(R - R_{X}) + R_{X}} R_{X} = U \cdot \frac{R_{X}}{R} = U \cdot \frac{1}{R} \cdot (R \cdot \frac{X}{l}) = U \cdot (\frac{X}{l}) = f(X)$$

Quan hệ tuyến tính





Mạch cầu:







$$U_g = U.(\frac{R_4}{R_4 + R_X} - \frac{R_3}{R_3 + R_2}) \text{ với } R_X = R_1.\frac{X}{l}$$

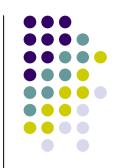
với 
$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$$
 có:

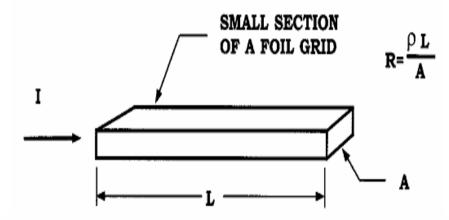
$$U_g = U.(\frac{R_4}{R_4 + R_X} - \frac{R_3}{R_3 + R_2}) = \frac{U}{2}.\frac{l - X}{l + X} = f(X)$$



- Ung dung:
  - Đo di chuyển thăng hay di chuyển góc Giá thành rẻ, mạch đo đơn giản.
  - Đo lực, áp suất, gia tốc....
  - Tần số nhỏ hơn 5Hz.







$$R = \rho \frac{L}{A}$$

where R = Resistance

 $\rho$  = Resistivity

L = Length

A =Area of the cross-section





$$\Delta R = \frac{\partial R}{\partial \rho} \, \Delta \rho + \frac{\partial R}{\partial L} \, \Delta L + \frac{\partial R}{\partial A} \, \Delta A$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = \frac{\Delta \rho}{\rho_0} + \frac{\Delta L}{L_0} - \frac{\Delta A}{A_0}$$



$$\frac{\Delta A}{A_0} = \frac{\Delta w}{w_0} + \frac{\Delta t}{t_0}$$

$$\frac{\Delta A}{A_0} = -2\nu \frac{\Delta L}{L_0}$$

γ là hệ số Poisson.



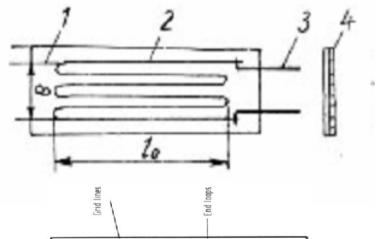


$$\frac{\Delta R}{R_0} = \frac{\Delta \rho}{\rho_0} + \frac{\Delta L}{L_0} \left( 1 + 2\nu \right)$$

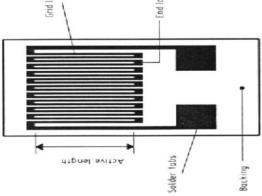
$$\frac{\Delta R}{R} = k \frac{\Delta l}{l}$$

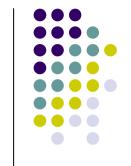
K hệ số phụ thuộc vào vật liệu với constantan k=2

- Cấu tạo: Có hai loại
  - Kiểu dây mảnh:



Kiểu màng mỏng:





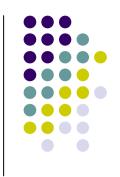
- Đế mỏng bằng vật liệu cách điện có độ bền cao.
- Dây dẫn hay màng bằng constantan, nicrom, platin-iridi.
- Dây và màng được cố định trên đế.
- Các cực đấu tín hiệu.
- Có thể dùng vật liệu bán dẫn (K cỡ vài trăm) nhưng có độ bền cơ học kém.



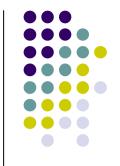


- Dây mảnh:
  - Có thể chế tạo kích thước lớn.
  - Giá thành rẻ.
  - Điện trở ngang lớn
  - Tiếp xúc nhỏ nên truyền biến dạng kém.
  - Tiếp xúc nhỏ nên truyền nhiệt kém



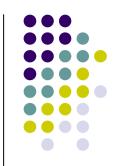


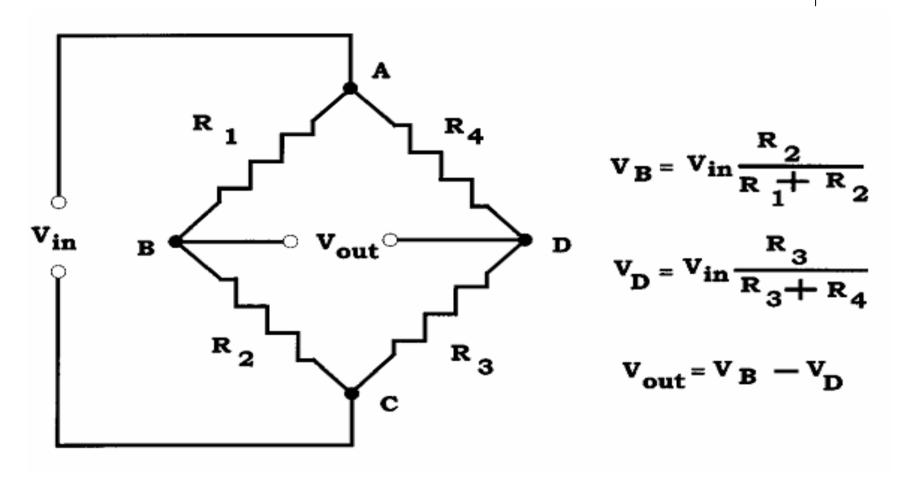
- Màng mỏng:
  - Kích thước nhỏ và có thể chế tạo hình dạng bất kỳ.
  - Điện trở ngang nhỏ.
  - Tiếp xúc tốt nên truyền biến dạng và nhiệt tốt.
  - Độ đồng đều ca



- Vật liệu: có độ nhậy cao, hệ số nhiệt nhỏ, điện trỏ xuất lớn.
- Bù sự thay đổi điện trở do nhiệt độ bằng cách sử dụng mạch cầu.









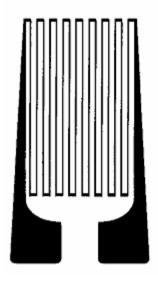


$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{R_1 R_3}{\left(R_1 + R_2\right) \left(R_3 + R_4\right)} \left( -\frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_3}{R_3} + \frac{\Delta R_4}{R_4} \right)$$

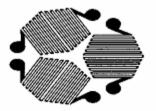




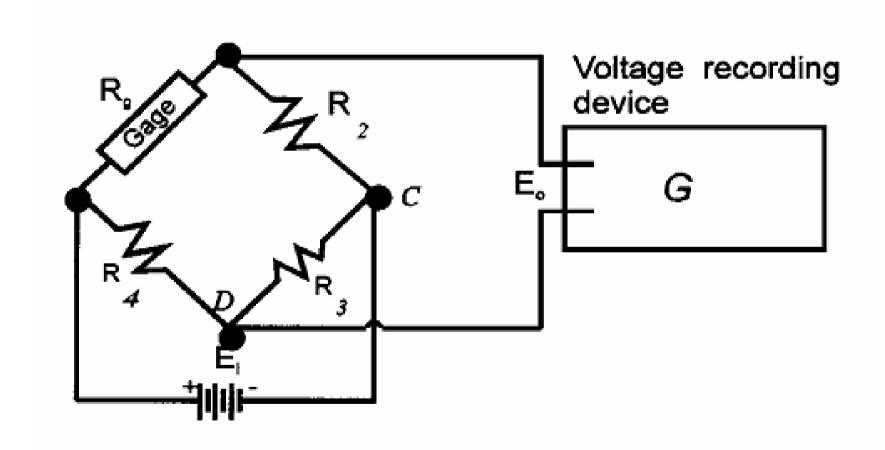
• Đo lực:



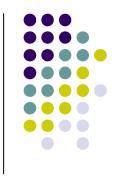


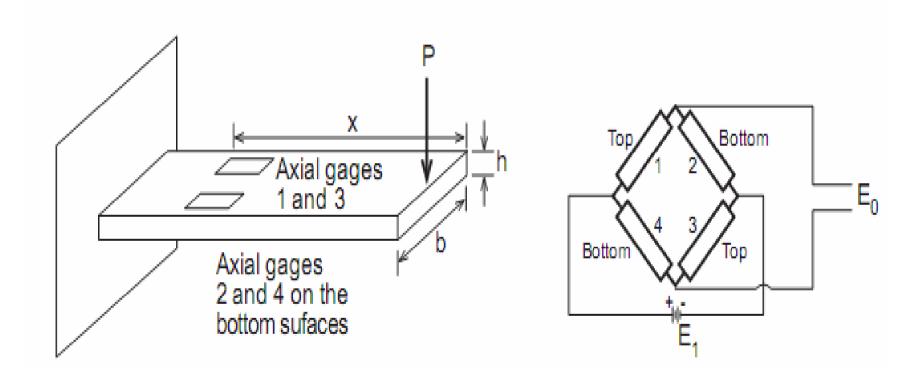
















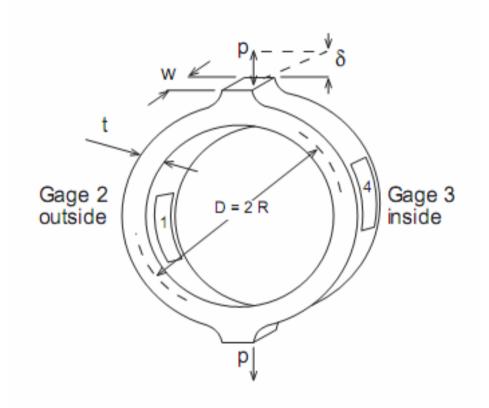
$$\varepsilon_1 = -\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = -\varepsilon_4 = \frac{6M}{Ebh^2} = \frac{6Px}{Ebh^2}$$

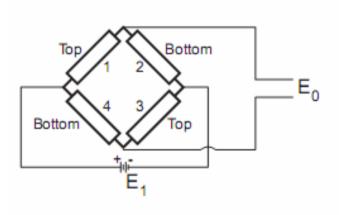
$$\frac{\Delta R_{1}}{R_{1}} = -\frac{\Delta R_{2}}{R_{2}} = \frac{\Delta R_{3}}{R_{3}} = -\frac{\Delta R_{4}}{R_{4}} = \frac{6S_{g}Px}{Ebh^{2}}$$

$$E_{o} = \frac{6S_{g}PxE_{1}}{Ebh^{2}}$$













- Nối giữa thiết bị đo với mạch cầu:
  - Cầu 4 dây.
  - Cầu 6 dây.





- Ung dung:
  - Đo lực, áp xuất, moment, biến dạng...
  - Đo các đại lượng biến thiên tần số nhỏ hơn vài chục KHz



Nhiệt điện trở là là điện trở thay đổi theo sự đổi nhiệt độ của nó:  $R_T = f(t^0)$ , đo  $R_T$  có thể suy ra nhiệt độ.

Nhiệt điện trở được chia ra thành:

Nhiệt điện trở kim loại và nhiệt điện trở bán dẫn.

Điện trở kim loại (RTD) theo nhiệt độ

$$R_T = R_0(1 + \alpha t + \beta t^2 + \gamma t^3)$$

Với Pt:

$$\alpha = 3.940.\ 10^{-3} / {}^{\circ}\text{C}$$

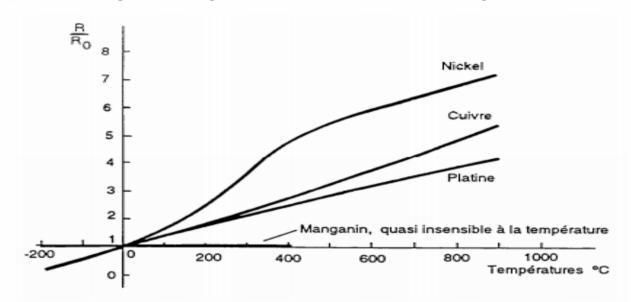
$$\beta = -5.8 \ 10^{-7} / {\rm ^{o}C^2}$$
;  $\gamma \approx 0$  trong khoảng  $0-600^{0}$ C;  $\gamma = -4 \ 10^{-12} / {\rm ^{o}C^3}$ 

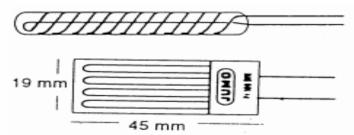
Đôi với đồng từ -50°C đến 200°C:  $\alpha = 4.27 \ 10^{-3}$ °C

 $\beta$  và  $\gamma$  trong phạm vi sử dụng vơi độ chính xác không cao thì coi như không đáng kể và quan hệ  $R_T$  và t coi như tuyến tính.



#### A, Nhiệt điện trở kim loại





Điện trở chuẩn hoá  $R_0$ =100  $\Omega$  tại  $0^{\circ}$ C



#### Hệ số nhiệt độ của một số kim loại

	Cu	Ni	Pt	W
T <sub>f</sub> , <sup>0</sup> C	1083	1453	1769	3380
C, J <sup>0</sup> C <sup>-1</sup> kg <sup>-1</sup>	400	450	135	125
$\lambda_t$ , W <sup>0</sup> C <sup>-1</sup> m <sup>-1</sup>	400	90	73	120
α <sub>1</sub> , <sup>0</sup> C- <sup>1</sup>	16,7.10-6	12,8.10-6	8,9.10-6	6.10-6
ρ, Ωm	1,72.10-8	10.10-8	10,6.10-8	5,52.10-8



Nhiệt điện trở bán dẫn

$$R_T = Ae^{\beta/T}$$

A và β đều không ổn định. Ta cũng có thể tính

$$\alpha = (-2.5\% + -4\%)/ {}^{0}C$$

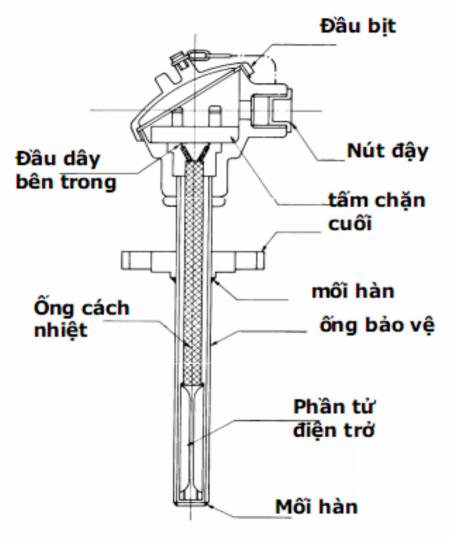
Thông thường được chế tạo từ các oxit bán dẫn đa tinh thể: MgO, MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, NiO, ZntiO<sub>4</sub>



Các bột oxit được trộn theo một tỉ lệ thích hợp, sau đó được nén với định dạng và thiêu kết ở nhiệt độ 1000°C



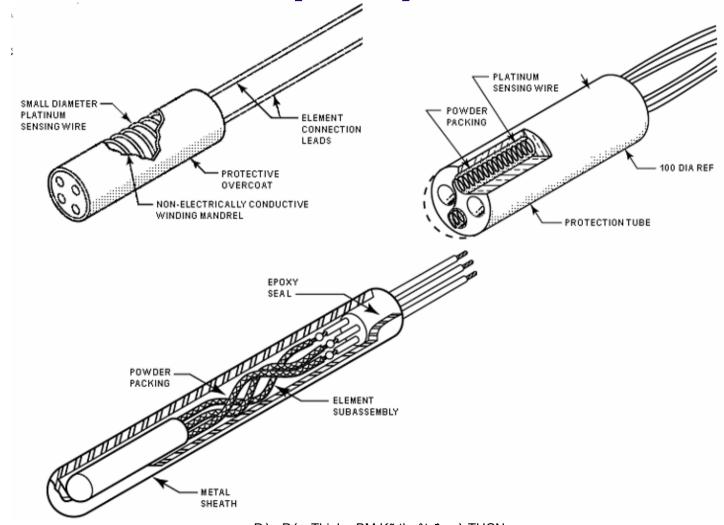
# Cảm biến nhiệt đ



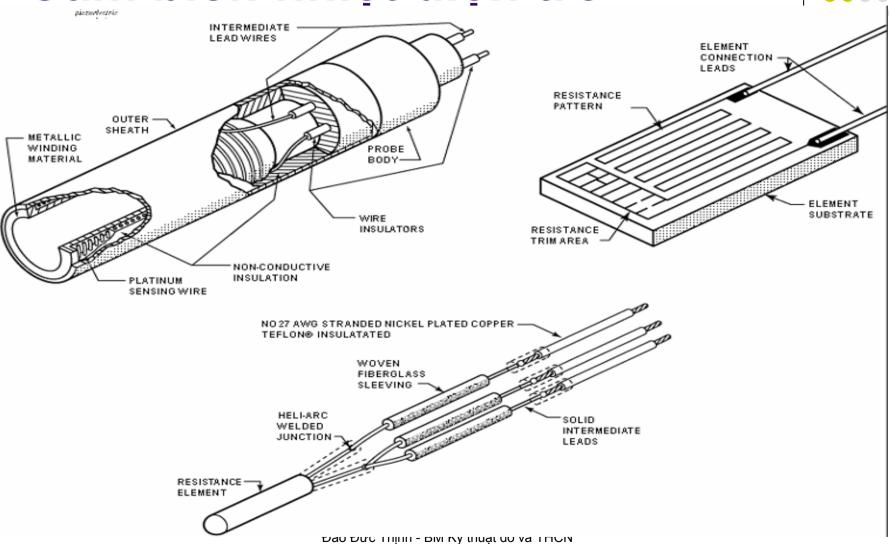
Đào Đức Thịnh - BM

Cấu tạo bên trong



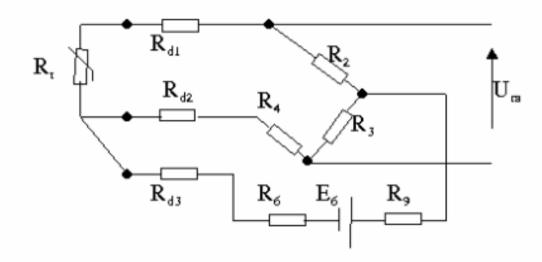


Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN



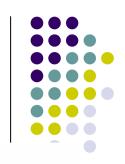


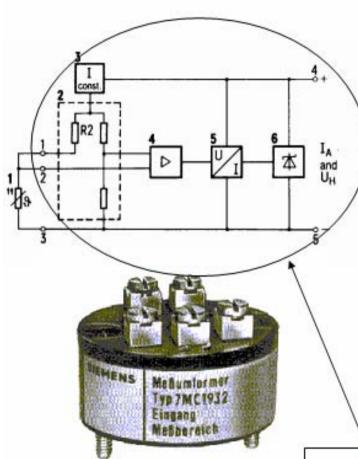
Bù điện trở dây



$$U_{R} = E \left( \frac{R_{t}}{R_{t} + R_{2}} - \frac{R_{3}}{R_{3} + R_{4}} \right)$$







✓ Nguồn dòng 2.5mA tạo ra một sự biến thiên điện áp trên điện trở là 100mV/100°C.

 $R_T = R_0 (1+\alpha t);$   $\alpha = 0.385\% / {}^{0}C$ 

✓ Nếu R<sub>T</sub> được cung cấp bằng nguồn dòng 259 mA thì khi nhiệt độ biến thiên 100°C

 $\Delta U = \Delta R_T$ .  $I = 0.385 \times 2.58 = 100 \text{mV}$ 

✓ Điện áp rơi trên R<sub>T</sub> được đưa vào khuếch đại bù điện áp ở 0°C và biến đổi áp thành dòng (4-20mA) để đưa vào hệ thống thu thập số đo.

- 1- Nhiệt điện trở 2- Modul vào
- 3- Dòng cung cấp (hằng)
- 4- Điện áp một chiều khuếch đại
- 5- Modul ra

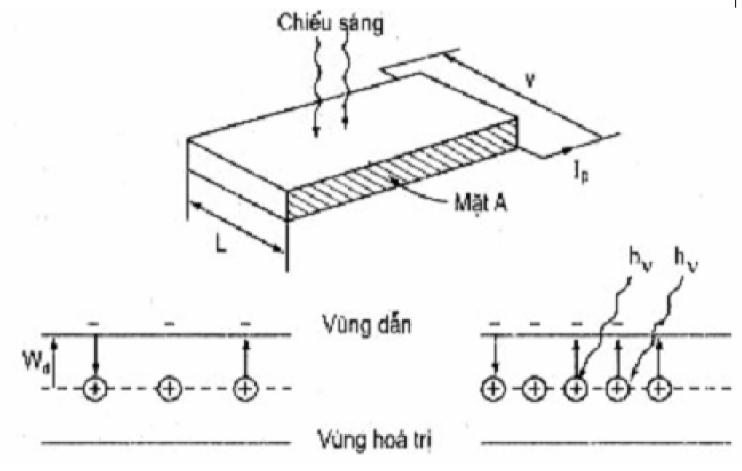
6- Điều chỉnh điện áp

Mạch chuẩn hoá

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN











$$n_0 = -\frac{a}{2r} + \left[\frac{a^2}{4r} + \frac{aN_d}{r}\right]^{\frac{1}{2}}$$

suy ra độ dẫn trong bóng tối của bán dẫn:

$$G_0 = q.\mu.n_0$$

với:  $\mu$  - độ linh động của điện tử; q - điện tích.



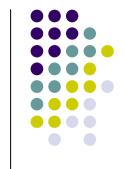


Khi bị chiếu sáng (năng lượng h $v \ge W_d$ )

$$n = \sqrt{\frac{g}{r}}$$

với: g - số điện tử được giải phóng trong một đơn vị thể tích trong thời gian 1s r - hệ số tái hợp

$$G_p = q.\mu..n$$

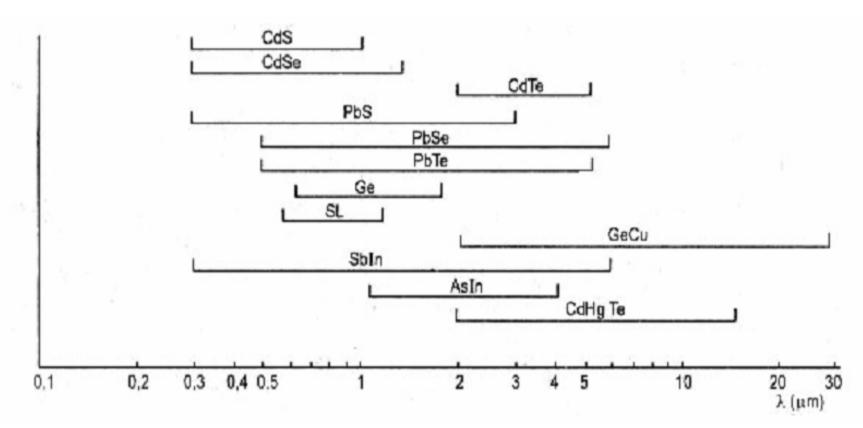


#### Quang trở

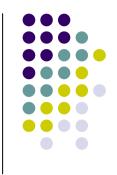
Vật liệu chế tạo quang điện trở là các bán dẫn đa tinh thể đồng nhất hoặc đơn tinh thể, bán dẫn riêng hoặc pha tạp. Loại đa tinh thể như: CdS, CdSe, CdTe, PbS, PbSe, PbTe. Đơn tinh thể như: Ge, Si tinh khiết hoặc pha tạp Au, Cu, Sb, In, SbIn, AsIn, PbIn, CdHgTe.

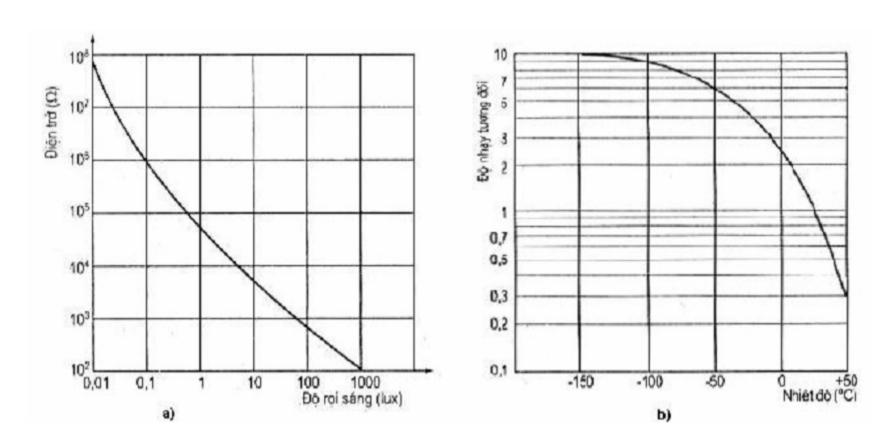












# Quang trở





Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN





- Ung dung:
  - Điều khiển relay.
  - Trong hệ thống báo động.
  - Đo tốc độ quay.
  - Đo vường độ sáng.





$$\gamma = \lambda$$
.  $fc = \lambda$ . $a (1/\Omega.m)$ 

c - nồng độ tương đương hay nồng độ phân tử (tính bằng gammol trên lít)

f - hệ số hoạt động của dung dịch (f = 1 ở dung dịch loãng và giảm khi c tăng).

a = f.c - độ hoạt động của dung dịch.

 $\lambda$  - hệ số, còn gọi là điện dẫn tương đương.





Một cách gần đúng phương trình đặc trưng của chuyển đổi có dạng:

$$R = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{l}{s} = \frac{1}{\lambda f c} \cdot \frac{l}{s}$$

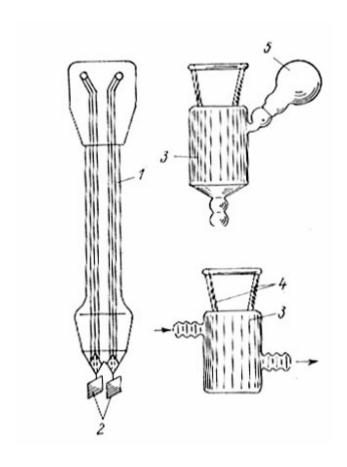
với: γ là điện dẫn suất của dung dịch

Chuyển đổi điện dẫn dung dịch được sử dụng rộng rãi để đo nồng độ của dung dịch (khi l và s không thay đổi), khi đó:

$$R = f(\gamma) = k \cdot \frac{1}{\gamma}$$



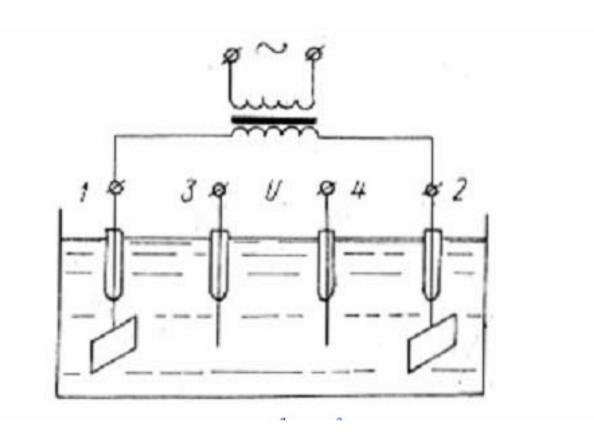




Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

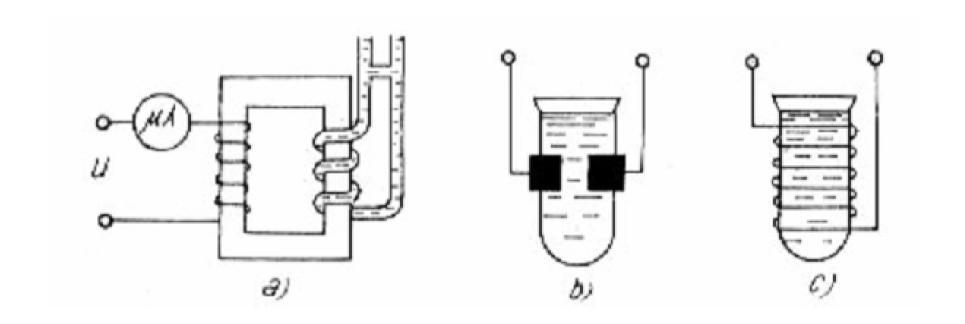










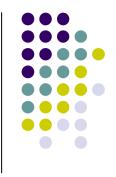


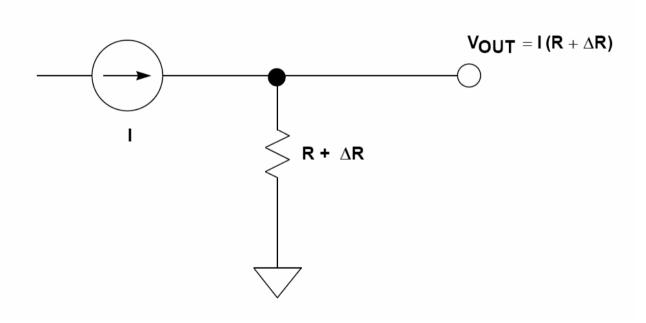




- Phần lớn mạch đo sử dụng mạch cầu.
- Điện trở cầu từ  $100\Omega$  vài trăn k $\Omega$ .
  - Điện trở lực căng: 120-350-3500
  - Loadcell: 350-3500
  - RTD:100,1000
  - ....

Sử dụng nguồn dòng

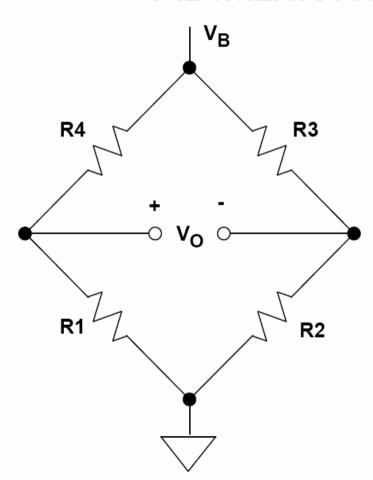








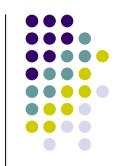
#### THE WHEATSTONE BRIDGE

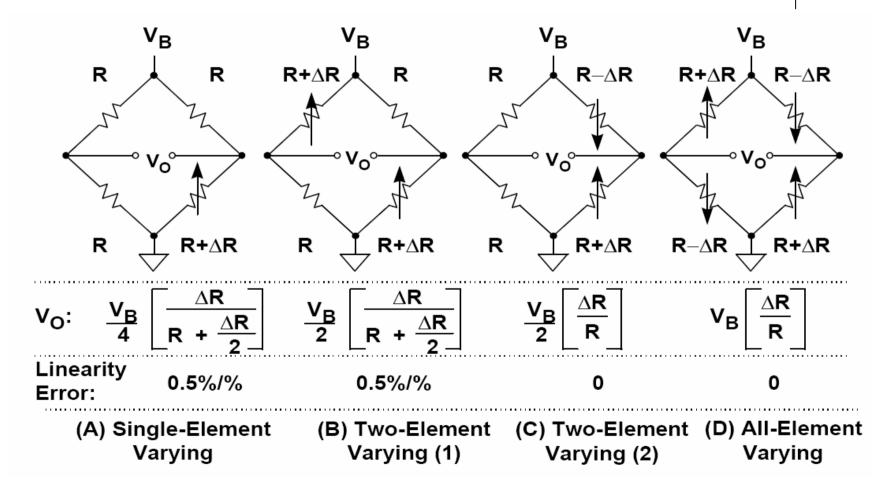


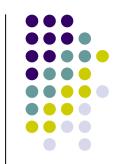
$$\begin{split} V_O &= \frac{R1}{R1 + R4} \, V_B - \frac{R2}{R2 + R3} \, V_B \\ &= \frac{\frac{R1}{R4} - \frac{R2}{R3}}{\left(1 + \frac{R1}{R4}\right) \! \left(1 + \frac{R2}{R3}\right)} \, V_B \end{split}$$

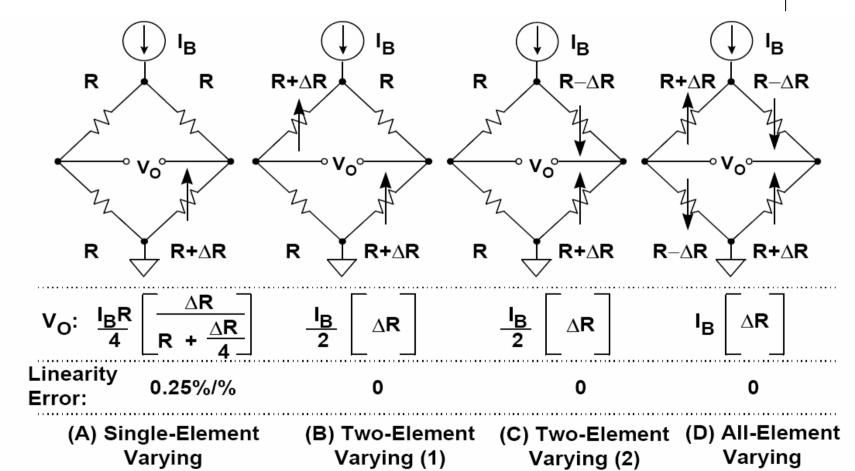
AT BALANCE,

$$V_{\mbox{\scriptsize O}} = 0 \quad \mbox{\scriptsize IF} \quad \frac{R1}{R4} = \frac{R2}{R3}$$



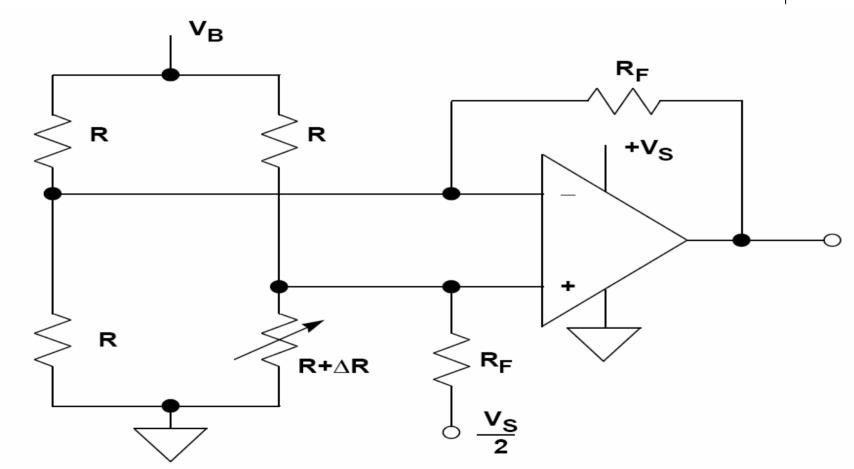


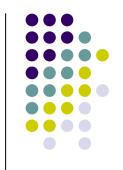


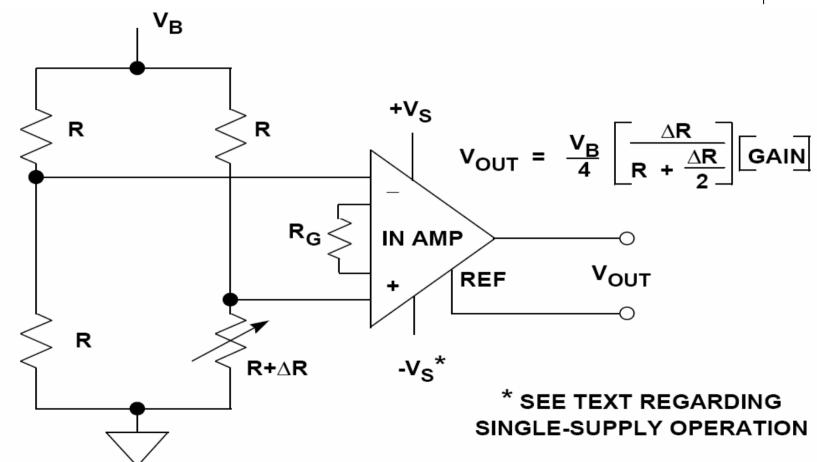


- Chọn 1,2,4 nhánh hoạt động
- Cấp nguồn dòng hay nguồn áp.
- Độ ổn định của nguồn cấp.
- Độ nhậy của cầu 1mV/V 10mV/V
- Điện áp ra định mức: 10-100mV
- Độ chính xác, nhiễu yêu cầu.
- Độ tuyến tính yêu cầu

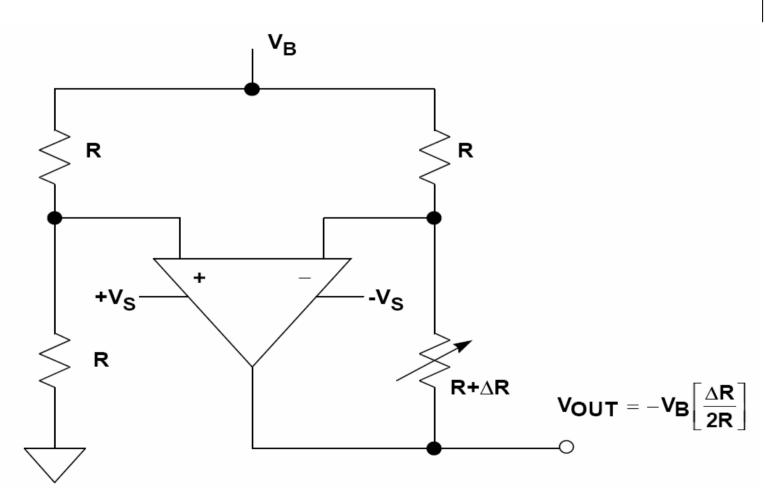




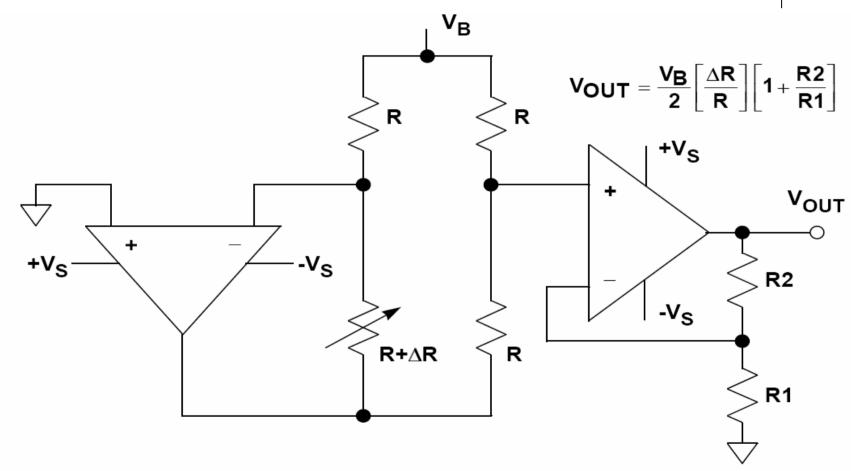




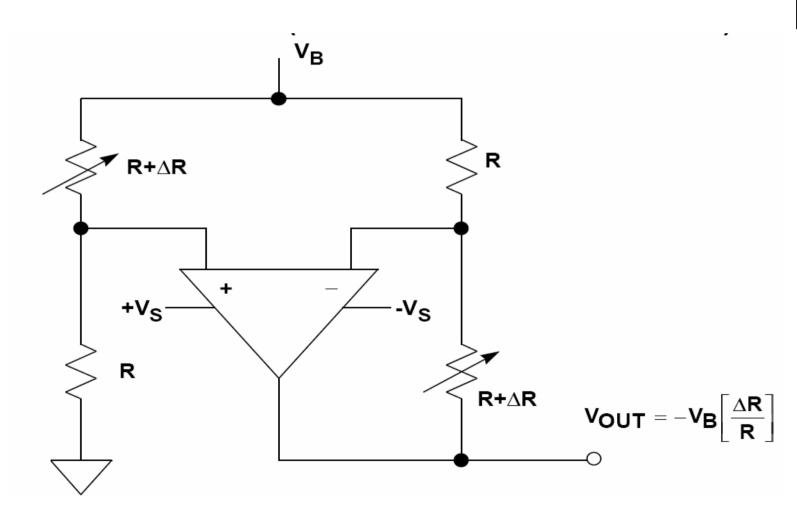




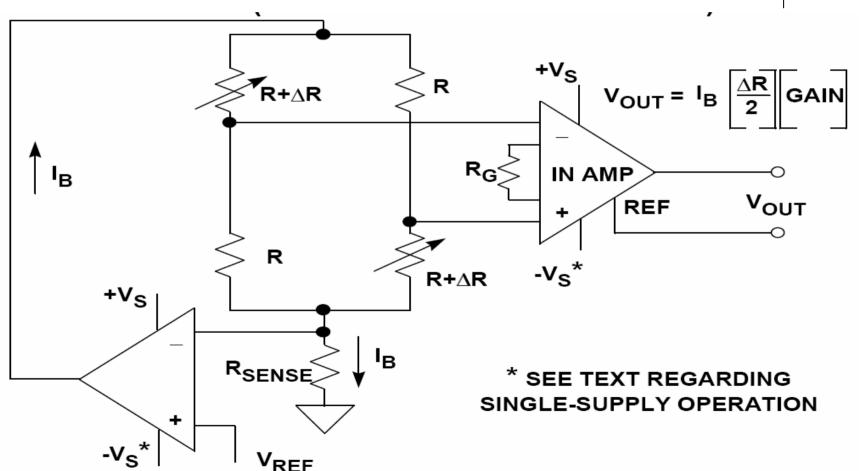




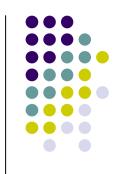


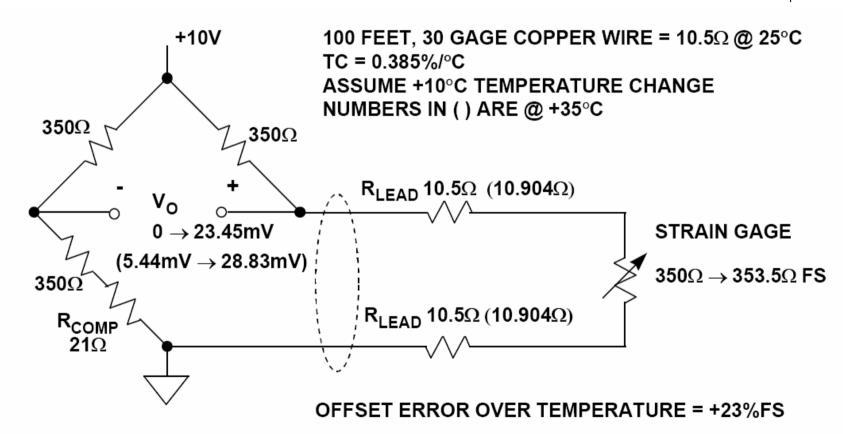






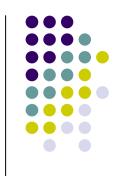


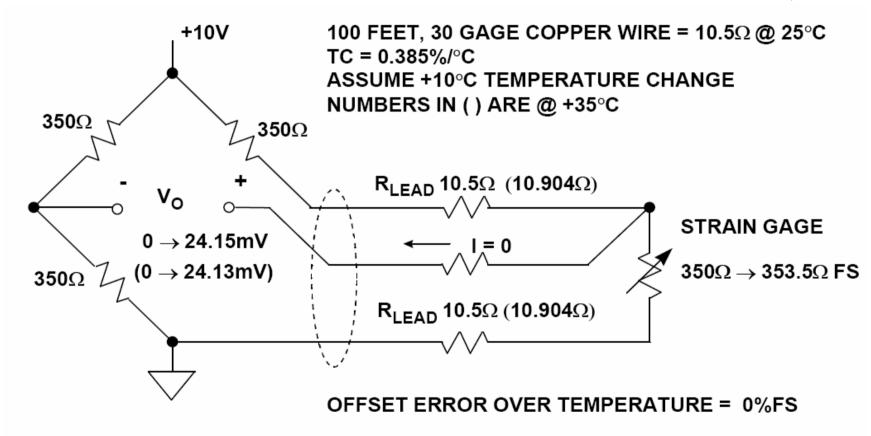




GAIN ERROR OVER TEMPERATURE = -0.26%FS







GAIN ERROR OVER TEMPERATURE = -0.08%FS



